
	<p>SI3434DV-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3434DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3434DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 75445 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3434DV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	75445 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 6.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 1mA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

















SI3434DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3434DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3434DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3434DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI3433DV-T1-GE3 V SI3433DV-T1-GE3 V	 SI3434DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP	 SI3433DV-T1-E3 VISHAY SI3433DV-T1-E3 VISHAY	 SI3435DV-T1-GE3 VISHAY SI3435DV-T1-GE3 VISHAY
 SI3434-TP Micro Commercial Components (MCC) MOSFET N-CHANNEL 30V 5A SOT23	 SI3434DV-T1 VISHAY SI3434DV-T1 VISHAY	 SI3434DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP	 SI3435DV-T1-E3 VISHAY SI3435DV-T1-E3 VISHAY

heiße Teile

Mehr

 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-T1-E3	 SI3425DV	 SI3429EDV-T1-GE3
 SI3429EDV-T1-GE3	 SI3430DV-T1	 SI3430DV-T1-GE3	 SI3430DV-T1-GE3	 SI3433BDV-T1
 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-GE3	 SI3433BDV-T1-GE3	 SI3433CDV-T1-E3
 SI3433CDV-T1-E3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433DN	 SI3433DV-T1
 SI3433DV-T1-E	 SI3433DV-T1-E3	 SI3433DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1	 SI3434DV-T1-E3
 SI3434DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1-GE3	 SI3435DV-T1	 SI3435DV-T1-E3	 SI3435DV-T1-GE3
 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-GE3	 SI3437DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-E3
 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3
 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-GE3	 SI3440DV-T1-GE3	 SI3441BDV
 SI3441BDV-T1	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-GE3	 SI3441BDV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited